

研究評価委員会

「ナノエレクトロニクス半導体新材料・新構造ナノ電子デバイス技術開発」
(中間評価) 分科会

日 時：平成21年8月25日(火曜日) 13:00～18:25

場 所：世界貿易センタービル WTC コンファレンスセンター 3階 Room A

議事次第

<公開の部>

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. 開会、分科会の設置、資料の確認 | 13:00～13:05(5分) |
| 2. 分科会の公開について | 13:05～13:10(5分) |
| 3. 評価の実施方法 | 13:10～13:15(5分) |
| 4. 評価報告書の構成について | 13:15～13:20(5分) |
| 5. プロジェクトの概要説明(NEDO 電子部) | 13:20～14:20(説明30分、質疑30分) |
| 位置付け・必要性、研究開発マネジメント | } 13:20～13:50(30分) |
| 研究開発成果、実用化の見通し | |
| 質疑 | 13:50～14:20(30分) |

—休憩(10分)—

14:20～14:30(10分)

<非公開の部>

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 6. プロジェクトの詳細説明【入替】 | (14:30～18:03) |
| ・分科会の非公開について | 14:30～14:35(5分) |

※以下、各テーマ20分(説明10分/質疑10分)×9テーマ、入替2分

- | | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| (1) カーボンナノチューブトランジスタ技術の研究開発【個別テーマ③-(1)】 | 14:35～14:57(入替2分、説明10分、質疑10分) |
| (2) シリコンナノワイヤトランジスタの知識統合研究開発【個別テーマ①-(1)】 | 14:57～15:19(入替2分、説明10分、質疑10分) |
| (3) ナノワイヤ FET の研究開発【個別テーマ①-(2)】 | 15:19～15:41(入替2分、説明10分、質疑10分) |
| (4) シリコンナノワイヤトランジスタの物性探究と集積化の研究開発
【個別テーマ①-(3)】 | 15:41～16:03(入替2分、説明10分、質疑10分) |
| (5) 新構造 FinFET による SRAM 技術の研究開発【個別テーマ②-(1)】 | 16:03～16:25(入替2分、説明10分、質疑10分) |

—休憩(10分)—

16:25～16:35(10分)

- (6) 次世代相変化メモリ技術の研究開発 【個別テーマ②-(2)】
16:35~16:57 (入替2分、説明10分、質疑10分)
- (7) ナノギャップ不揮発性メモリ技術の研究開発 【個別テーマ②-(3)】
16:57~17:19 (入替2分、説明10分、質疑10分)
- (8) シリコンプラットフォーム上III-V族半導体チャンネルトランジスタ技術の研究開発
【個別テーマ③-(2)】 17:19~17:41 (入替2分、説明10分、質疑10分)
- (9) シリコンウェハ中の原子空孔濃度定量評価技術の研究開発 【個別テーマ③-(3)】
17:41~18:03 (入替2分、説明10分、質疑10分)

(一般傍聴者入室) (2分)

18:03~18:05(2分)

<公開の部>

7. まとめ・講評 18:05~18:20(15分)
8. 今後の予定、その他 18:20~18:25(5分)
9. 閉会